

证书号第8152272号



专利公告信息

发明专利证书

发明名称：基于低损耗赝自旋极化拓扑边界态的高性能硅基拓扑微腔

专利权人：南昌大学

地址：330103 江西省南昌市红谷滩新区学府大道999号

发明人：邓伟民;张亦豪;于天宝;万里鹏

专利号：ZL 2025 1 0758403.0

授权公告号：CN 120255073 B

专利申请日：2025年06月09日

授权公告日：2025年08月12日

申请日时申请人：南昌大学

申请日时发明人：邓伟民;张亦豪;于天宝;万里鹏

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，并予以公告。
专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。

局长
申长雨

申长雨

